

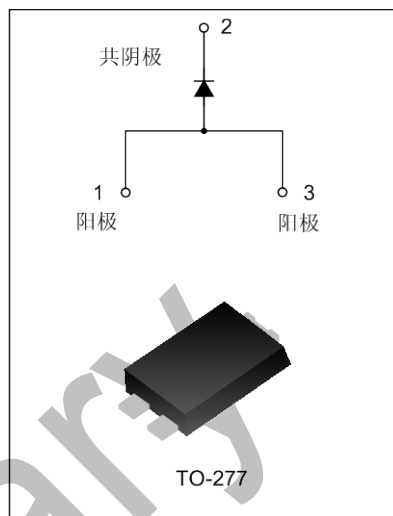
10A、45V肖特基整流管

描述

SBD10L45AT3 是采用 TMBS 工艺制作而成的 Low VF 肖特基整流二极管，保护环结构可以起到过压保护的作用，并且可以提高产品的可靠性。产品广泛应用于开关电源、极性保护电路等各类电子线路中。

特点

- ◆ Trench MOS Schottky 工艺技术
- ◆ 抗冲击能力强
- ◆ 低功耗，高效率
- ◆ 正向压降低
- ◆ 结温可以到 150°C



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SBD10L45AT3	TO-277	10L45A	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	额定值	单位
最大反向峰值电压	V_{RRM}	45	V
正向平均整流电流	I_{FAV}	10	A
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	180	A
工作结温范围	T_J	-65~150	$^\circ\text{C}$
芯片存储温度范围	T_{STG}	-65~150	$^\circ\text{C}$

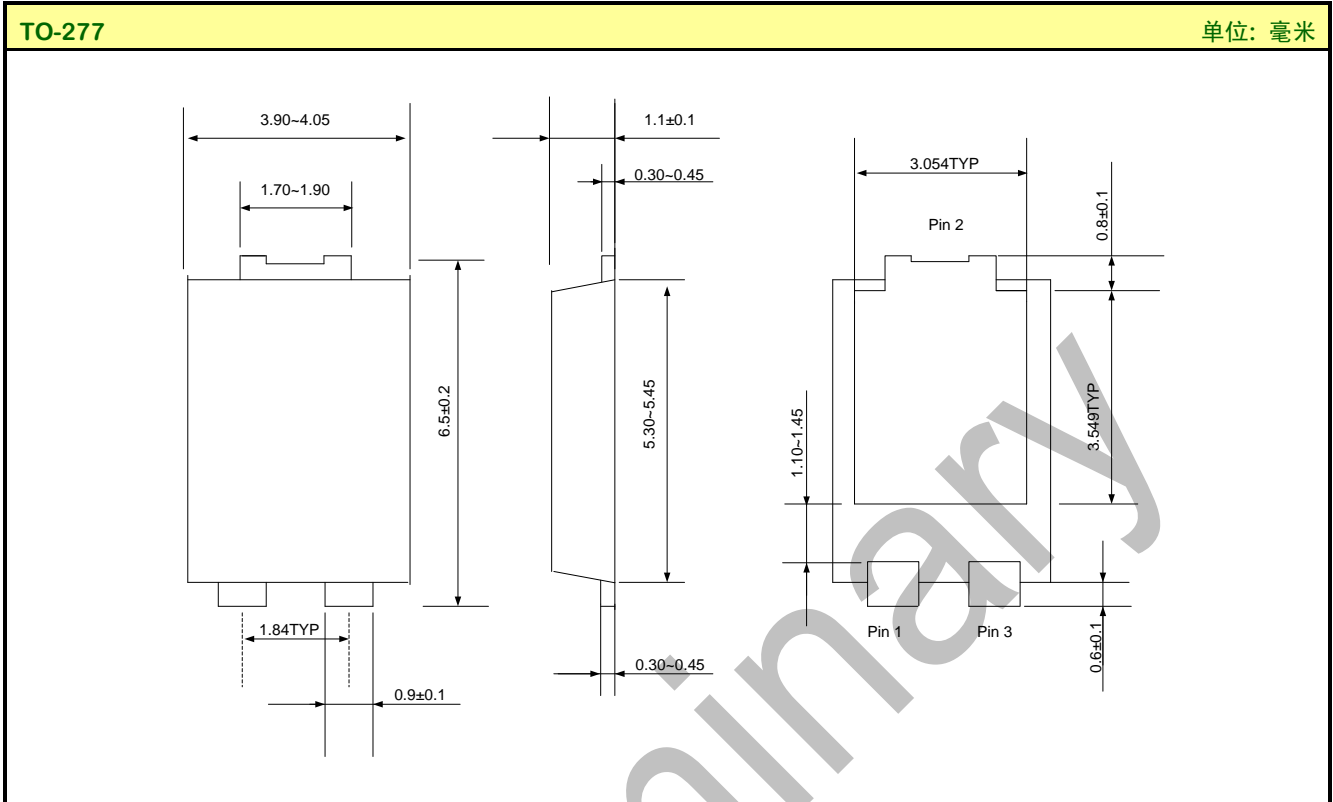
热阻特性

参数名称	符号	额定值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	52	$^\circ\text{C/W}$

电参数规格(单管脚)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=10\text{A}; T_J=25^\circ\text{C}$	--	0.43	0.47	V
		$I_F=10\text{A}; T_J=125^\circ\text{C}$	--	0.38	0.42	V
反向漏电流	I_R	$V_R=45\text{V}; T_J=25^\circ\text{C}$	--	100	300	μA
		$V_R=45\text{V}; T_J=100^\circ\text{C}$	--	-	15	mA

封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 **Silan** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SBD10L45AT3	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	0.1	作 者:	马丽青
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 初稿
-

Preliminary